

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы интегральные К198НТ1АТВК, К198НТ1БТВК соответствуют техническим условиям АДБК.431410.926 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

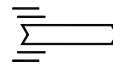
Пере проверка произведена \_\_\_\_\_  
Дата

Штамп ОТК

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ-Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ».

Допустимое значение статического потенциала 100 В.



## МИКРОСХЕМЫ К198НТ1АТВК, К198НТ1БТВК

Россия, 248009, г.Калуга,  
Грабцевское шоссе,43

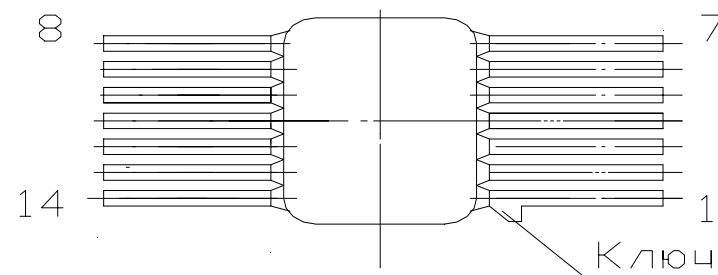
Код ОКП : 6331328881 – К198НТ1АТВК  
6331328891 - К198НТ1БТВК

## ЭТИКЕТКА

ЛСАР.431130.030 ЭТ4

Микросхемы интегральные К198НТ1АТВК,  
К198НТ1БТВК – матрица транзисторов N-P-N типа.  
Климатическое исполнение УХЛ.

## Схема расположения выводов

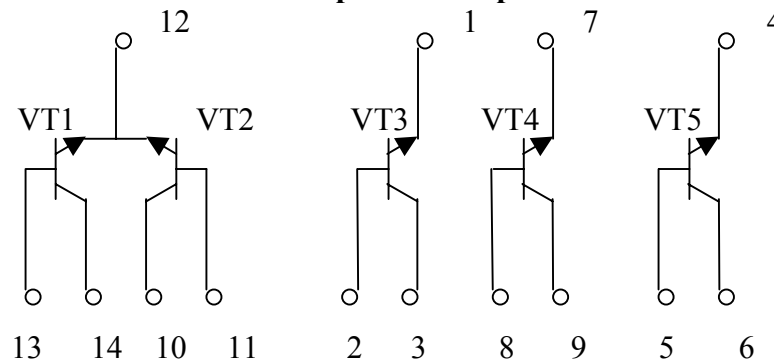


Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 0,8 г.

## Схема электрическая принципиальная



## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при температуре (25±10) °С

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		К198НТ1АТВК		К198НТ1БТВК	
		не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока при: $U_{CB}=3$ В; $I_E=0,5$ мА	$h_{21E}$	20	125	60	250
Обратный ток коллектора, мкА, при: $U_{CB}=6$ В	$I_{CBO}$	-	0,04	-	0,04
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, при: $I_C=3$ мА; $I_B=0,5$ мА	$U_{BE sat}$	-	1,0	-	1,0
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, при: $I_C=3$ мА; $I_B=0,5$ мА	$U_{CE sat}$	-	0,7	-	0,7
Разброс напряжения база-эмиттер (транзисторов VT1, VT2), мВ, при: $\Sigma I_E=0,5$ мА; $U_{CB}=3$ В	$\Delta U_{BE}$	-	4,0	-	4,0
Разброс статических коэффициентов передачи тока (транзисторов VT1, VT2), %, при: $U_{CB}=3$ В; $I_E=0,5$ мА	$\Delta h_{21E}$	-	15	-	15

Драгоценных металлов не содержится.

Цветных металлов не содержится.

### НАДЕЖНОСТЬ

Наработка микросхем ( $T_n$ ) в режимах и условиях, допускаемых ТУ, - 50000 ч, а в следующем облегченном режиме при напряжениях, не превышающих 60% от предельно допустимых значений, - 60000 ч.

Интенсивность отказов в течение наработки не более  $1 \cdot 10^{-6}$  1/ч.

Гамма-процентный срок сохраняемости ( $T_{Cy}$ ) микросхем при  $\gamma=95\%$  при хранении их в условиях, установленных ГОСТ 21493-76, - 15 лет.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие микросхем требованиям АДБК.431410.926 ТУ при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, установленных ТУ.

Гарантийный срок хранения 15 лет со дня изготовления.

Гарантийная наработка:

- 50000 ч – в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
- 60000 ч – в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока хранения.